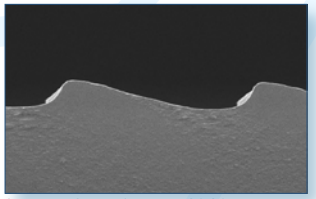
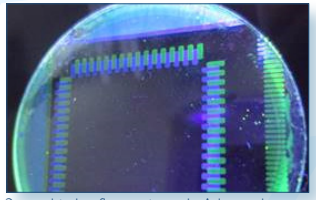
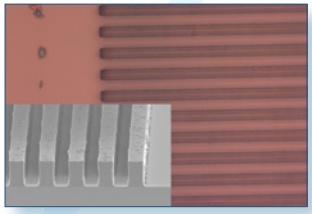
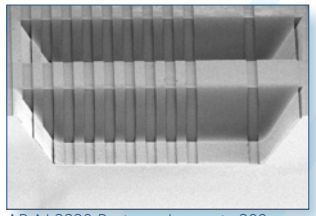
Bedeutende Neuentwicklungen

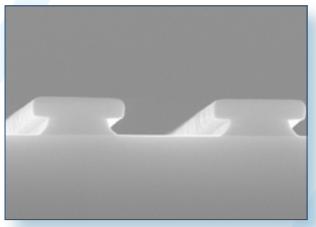
Atlas 46 - Negativ Photoresist bis 100 µm stabile Resststrukturen, adäquat SU-8	AR-N 4600
EOS 72 - Positiv E-Beamresist, CAR hochauflösend, höchstempfindlich	SX AR-P 7200
Phoenix 81 - Thermostrukturierbarer Positivresist für NanoFrazor-Anwendung	AR-P 8100
Medusa 82 - Negativ-E-Beamresist vglb. HSQ prozessstabiler o. empfindlicher, höchstauflösend	SX AR-N 8200, 8250
Protective Coating, 40% KOH-, 50% HF-stabil	SX AR-PC 5000/41
Thermostabiler Negativ-Photoresist bis 300 °C, geeignet für 2-Lagensysteme	SX AR-N 4340/7
Floureszierende Photo- und E-Beam Resists	SX AR-P/N 8500

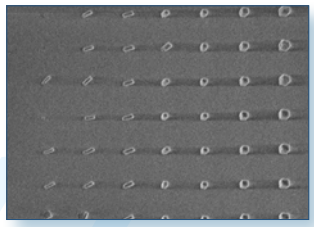

Sinus-Profil mit AR-N 7720.30


3 verschieden fluoreszierende Atlasstrukturen


Atlas 46 R 5 µm line & space, Strukturen sind leicht entfernbar


AR-N 2220 Resststrukturen in 200 µm tiefen Ätzgruben


Thermostabiles 2-Lagen-Lift-off -System mit AR-BR 5460 und SX AR-N 4340/7


60-150 nm Quader (100 nm hoch) auf Glas mit AR-N 7700.08 und AR-PC 5091.02

ALLRESIST Gesellschaft für chemische Produkte zur Mikrostrukturierung mbH

Firmengründung: 16. Oktober 1992, HRB 7805 AG Frankfurt (Oder)

Geschäftsführende Gesellschafter: Brigitte und Matthias Schirmer

Integriertes Managementsystem: Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 : 2015, Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 : 2015

Mitglied in Wissenschafts- und Wirtschaftsverbänden: Silicon Saxony, iq Brandenburg, Verein Sichere Identität, IVAM

Preise & Auszeichnungen:

Ludwig-Erhard-Preis
Qualitätspreis Berlin-Brandenburg
Brandenburger Innovationspreis
Deutschlands Kundenchampions
Deutschlands Mitarbeiterchampions
Exzellente Wissensorganisation
Technologietransferpreis Brandenburg
Zukunftspreis Ostbrandenburg
Brigitte Schirmer - Zweitplatzierte Unternehmerin Brandenburgs

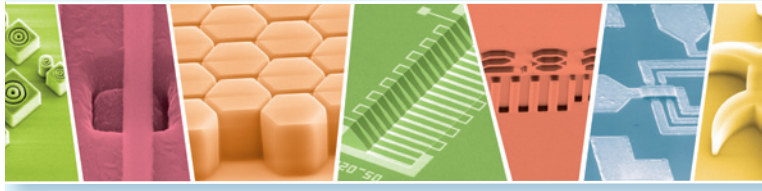
ALLRESIST GmbH
Am Biotop 14
15344 Strausberg
Tel. 03341 / 35 93-0
Fax 03341 / 35 93-29
info@allresist.de
order@allresist.de
www.allresist.de

ALLRESIST

Innovation
Kreativität
Kundenspezifische Lösungen

Resists und Prozesschemikalien

für die Optische und Elektronenstrahl-Lithographie



über 25 Jahre Allresist

Innovation, Kreativität, kundenspezifische Lösungen

Ludwig Erhard Preis 2012 Preisträger
Technologie Stiftung Brandenburg
Zukunftspreis Brandenburg
Deutschlands Kundenchampions 2010
Deutschlands Mitarbeiterchampions 2012
Exzellente Wissensorganisation
Umweltpartnerschaft Brandenburg
Brandenburgischer Innovationspreis

ALLRESIST

Innovation
Kreativität
Kundenspezifische Lösungen

Produktprofil ALLRESIST

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Photo- & E-Beam Resists sowie Prozesschemikalien zur Herstellung elektronischer Bauteile, Mikrochips

- Breite Produktpalette - Resists für (nahezu) alle Standardtechnologien
- Prozessangepasste Resists nach Kundenwunsch für Industriekunden - Dieser Service ist weltweit einzigartig
- Entwicklung innovativer Produkte für neue Applikationen & Technologien
- Ausgeprägte Industrieforschung, Projektbearbeitungen in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen
- Individuelle kompetente Produkt- und Technologieberatung
- Kurze Lieferzeiten, vorrätige Produkte sofort möglich
- Kundenfreundliche Packungsgrößen ab 250 ml, Testmuster ab 100 ml

Auswertung von Kundenwünschen und Festlegung neuer Produkte - Strategiediskussion im Lenkungkreis

Anwenderorientierte Resists

ALLRESIST kann aufgrund ihrer Kompetenz und Flexibilität spezielle Anwenderwünsche bereits bei der Konzeptionierung & Entwicklung neuer Resists berücksichtigen. Für Industriekunden bieten wir maßgeschneiderte Resists bzw. modifizierte Standardresists entsprechend den jeweiligen Technologieerfordernissen an.

Einführung kundenspezifischer Resists vor Ort

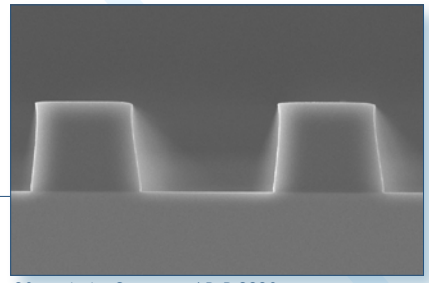
Wir bieten Verdünner, Entwickler, Stopper, Remover und Haftvermittler als optimal auf die Resists abgestimmte Prozesschemikalien an.

Ausführliche Produktinformationen mit Resist-Wiki, AR NEWS, FAQ und EU-Sicherheitsdatenblättern finden Sie auf www.allresist.de.

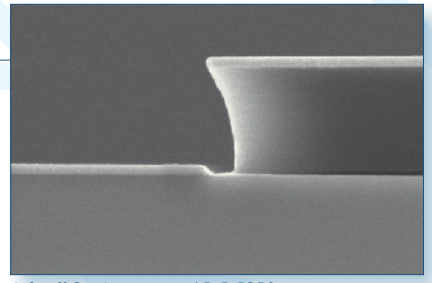
St.: 01/2021

Produktübersicht

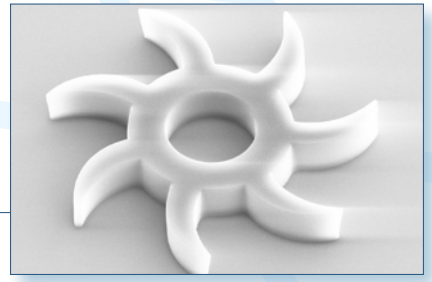
		D_0 [µm] 4000 rpm	
Positiv-Photoresists, i-line, g-line	Sprühbeschichtung für verschied. Anwendungen	[0,5 - 10]	AR-P 1210, 1220, 1230
	Maskenherstellung, Feinteilungen, hochauflösend	1,0 ; 0,6 ; 0,1	AR-P 3110, 3120, 3170
	Dicklacke hoher Maßhaltigkeit bis 40/100/20 µm	10 ; 5 ; 10	AR-P 3210, 3250, 3220
	Große Prozessbreite, hochauflösend	2,0 ; 1,4	AR-P 3510 (T), 3540 (T)
	Hoher Kontrast, höchstauflösend, sub-µm	1,4	AR-P 3740
	Unterschnittene Strukturen (1-Lagen-lift-off)	5,0 ; 1,0	AR-P 5320, 5350
Sondersysteme	Protective Coating, 40 % KOH-ätzstabil	2,2 ; 2,8	AR-PC 504; 5040
	Leitfähige Schutzlacke für E-Beamresists	0,04	Electra 92 AR-PC 5090, 5091
	Bottomresist für 2-L-Lift-off-System (pos./neg.)	1,0 ; 0,5	AR-BR 5460, 5480
Neg.-Photoresists	Sprühbeschichtung für verschied. Anwendungen	[0,5 - 10]	AR-P 2210, 2220, 2230
	Höchstempfindlich, hochauflösend, i-, g-line	1,4	AR-N 4340
	Hohe Schichten bis 100 / 50 / 20 µm i-line, E-Beam leicht removbar, Profile hoher Kantensteilheit für exzellente Auflösung	50 ; 25 ; 10 (1000 rpm)	CAR 44 AR-N 4400-50, -25 AR-N 4400-10, -05
Positiv-E-Beamresists	Copolymer PMMA/MA 33%, höchstauflösend	0,09 …. 1,75	AR-P 617
	PMMA 50K, 200K, 600K, 950K, höchstauflösend Chlorbenzen (1), Anisol (2), Ethyllactat (9)	0,01 …. 1,87	AR-P 641-671, 632-672 AR-P 639-679
	Styrenacrylat, höchstauflösend, hochempfindlich, sehr plasmaätzresistent und prozessstabil	CSAR 62 0,08 … 0,80	AR-P 6200
	Hohe PMMA-Schichten bis 100 µm, Tief-UV	350 rpm: 45-95	AR-P 6510
Negativ-E-Beam	Mix & match, ätzresistent, hochauflösend	0,4 ; 0,1	AR-N 7500
	Mix & match, ätzresistent, höchstauflösend	0,4 ; 0,2 ; 0,1	AR-N 7520 (neu)
	CAR, hochauflösend, steile Gradation digit. Abb.	0,4 ; 0,1	AR-N 7700
	CAR, hochauflösend, flache Gradation	1,4 ; 0,25	AR-N 7720



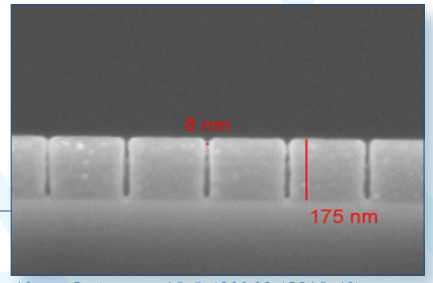
20 µm hohe Stege mit AR-P 3220



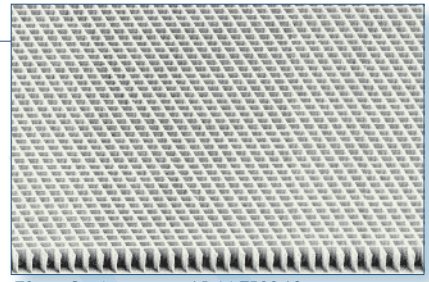
Lift-off-Strukturen mit AR-P 5350



Turbinenrad 500 µm mit AR-N 4400-50 (CAR 44)



10 nm Gräben mit AR-P 6200.09 (CSAR 62)



70 nm Strukturen mit AR-N 7500.18